(19) 日本国特許庁(JP) (12) 特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第6768444号

(P6768444)

(45) 発行日 令和2年10月14日(2020.10.14)

(24) 登録日 令和2年9月25日 (2020.9.25)

Μ

Ν

(51) Int.Cl. F I **B 2 3 K 26/00 (2014.01)** B 2 3 K 26/00 **B 2 3 K 26/062 (2014.01)** B 2 3 K 26/062

請求項の数6 (全30頁)

 (73)特許権者 000236436 浜松ホトニクス株式会社 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1 (74)代理人 100088155 弁理士 長谷川 芳樹 (74)代理人 100113435 弁理士 黒木 義樹 (74)代理人 100140442 弁理士 柴山 健一 (72)発明者 伊ケ崎 泰則 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内
 審査官 岩見 勤

B23K

26/00

(54) 【発明の名称】 レーザ加工装置、及び、動作確認方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

レーザ光を対象物に照射してレーザ加工を行う第1モードと、前記第1モードと異なる 第2モードと、を少なくとも有するレーザ加工装置であって、

前記レーザ光を出力するレーザ光源と、

前記レーザ光源から出力された前記レーザ光を位相パターンに応じて変調して出射する 空間光変調器と、

前記空間光変調器から出射された前記レーザ光を前記対象物に集光する対物レンズと、 前記空間光変調器に表示する位相パターンを制御する制御部と、

前記第2モードが実行されているときに、前記空間光変調器の動作が正常であるか否か ¹⁰の判定を行う判定部と、

を備え、

前記制御部は、前記第2モードが実行されているときに、前記空間光変調器に表示する 前記位相パターンを切り替えるための切替制御を行い、

前記判定部は、前記空間光変調器から出射された前記レーザ光の前記切替制御の前と前 記切替制御の後との間の強度の変化に基づいて前記判定を行う、

レーザ加工装置。

【請求項2】

前記制御部は、前記第2モードが実行されているときに、前記空間光変調器に表示する 前記位相パターンを第1パターンから回折格子パターンを含む第2パターンに切り替える ² ための前記切替制御を行い、

前記判定部は、前記切替制御の前の前記レーザ光の強度から前記切替制御の後の前記レ ーザ光の強度を減算して強度差を計算すると共に、前記強度差が閾値よりも大きいか否か に基づいて前記判定を行う、

請求項1に記載のレーザ加工装置。

【請求項3】

前記レーザ光の光路における前記空間光変調器と前記対物レンズとの間に配置され、前記レーザ光を集束する集束レンズと、

前記レーザ光の光路における前記集束レンズの後側の焦点位置に配置され、前記回折格 子パターンに応じて回折された前記レーザ光の一定次数以上の回折光を遮断するスリット ¹⁰ 部材と、

を備える、

請求項2に記載のレーザ加工装置。

【請求項4】

前記第2モードは、前記対物レンズから出射された前記レーザ光の強度を測定するため の計測モードであり、

前記判定部は、前記レーザ光の光路における前記対物レンズの後段に配置されたパワー メータにより取得された前記レーザ光の強度に基づいて前記判定を行う、

請求項1~3のいずれか一項に記載のレーザ加工装置。

【請求項5】

前記対物レンズの入射瞳面と共役な撮像面を有し、前記レーザ光の画像を取得するカメ ラを備え、 20

前記判定部は、前記カメラにより取得された前記画像に基づいて取得された前記レーザ 光の強度に基づいて前記判定を行う、

請求項1~3のいずれか一項に記載のレーザ加工装置。

【請求項6】

レーザ光を出力するレーザ光源と、前記レーザ光源から出力された前記レーザ光を位相 パターンに応じて変調して出射する空間光変調器と、前記空間光変調器から出射された前 記レーザ光を対象物に集光する集光レンズと、を備えるレーザ加工装置の前記空間光変調 器の動作確認方法であって、

30

40

前記レーザ加工装置において、前記レーザ光を前記対象物に照射してレーザ加工を行う 第1モードとは異なる第2モードが実行されているときに、前記空間光変調器に表示する 前記位相パターンを切り替えるための切替制御を行う第1ステップと、

前記第2モードが実行されているときに、前記切替制御の前と前記切替制御の後との間 の前記レーザ光の強度の変化に基づいて、前記空間光変調器の動作が正常であるか否かの 判定を行う第2ステップと、

を含む動作確認方法。

【発明の詳細な説明】

- 【技術分野】
- [0001]

本発明は、レーザ加工装置、及び、動作確認方法に関する。

【背景技術】

[0002]

特許文献1には、レーザ光を加工対象物に照射することにより加工対象物のレーザ加工 を行うレーザ加工装置が記載されている。このようなレーザ光加工において、レーザ光源 から出力レーザ光は、空間光変調器により変調された後に、対物レンズによって加工対象 物に集光される。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0 0 0 3]

【特許文献1】特開2011-51011号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

上述したようなレーザ加工装置においては、空間光変調器の動作が正常でない場合には、加工対象物に対して適切なレーザ光の照射ができないおそれがある。したがって、いずれかのタイミングで空間光変調器の動作確認を行うことが必要である。これに対して、本 発明者らは、空間光変調器の動作確認のタイミングとして、レーザ加工時以外のタイミン グが望ましいとの知見を得た。

【 0 0 0 5 】

10

そこで、本発明は、加工時以外のタイミングで空間光変調器の動作確認が可能なレーザ 加工装置、及び、動作確認方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0006]

本発明に係るレーザ加工装置は、レーザ光を対象物に照射してレーザ加工を行う第1モ ードと、第1モードと異なる第2モードと、を少なくとも有するレーザ加工装置であって 、レーザ光を出力するレーザ光源と、レーザ光源から出力されたレーザ光を位相パターン に応じて変調して出射する空間光変調器と、空間光変調器から出射されたレーザ光を対象 物に集光する集光レンズと、空間光変調器に表示する位相パターンを制御する制御部と、 第2モードが実行されているときに、空間光変調器の動作が正常であるか否かの判定を行 う判定部と、を備え、制御部は、第2モードが実行されているときに、空間光変調器に表示する位相パターンを切り替えるための切替制御を行い、判定部は、空間光変調器から出 射されたレーザ光の切替制御の前と切替制御の後との間の強度の変化に基づいて判定を行 う。

[0007]

本発明に係る動作確認方法は、レーザ光を出力するレーザ光源と、レーザ光源から出力 されたレーザ光を位相パターンに応じて変調して出射する空間光変調器と、空間光変調器 から出射されたレーザ光を対象物に集光する集光レンズと、を備えるレーザ加工装置の空 間光変調器の動作確認方法であって、レーザ加工装置において、レーザ光を対象物に照射 してレーザ加工を行う第1モードと異なる第2モードが実行されているときに、空間光変 調器に表示する位相パターンを切り替えるための切替制御を行う第1ステップと、第2モ ードが実行されているときに、空間光変調器から出射されたレーザ光の切替制御の前と切 替制御の後との間の強度の変化に基づいて、空間光変調器の動作が正常であるか否かの判 定を行う第2ステップと、を含む。

[0008]

このレーザ加工装置及び動作確認方法においては、レーザ加工を行う第1モードと異な る第2モードが実行されているときに、空間光変調器に表示する位相パターンの切替制御 が行われる。空間光変調器の動作が正常であれば、切替制御の前後において異なる位相パ ターンによりレーザ光が変調され、レーザ光の強度変化が生じる。一方、空間光変調器の 動作が正常でない場合には、切替制御の前後において位相パターンが適切に切り替わらな い結果、レーザ光の強度変化が生じない場合がある。したがって、第2モードが実行され ているときに、切替制御の前後のレーザ光の強度の変化に基づいて、空間光変調器の動作 が正常であるか否かの判定を行うことにより、加工時以外のタイミングで空間光変調器の 動作確認を行うことが可能である。

[0009]

本発明に係るレーザ加工装置においては、制御部は、第2モードが実行されているとき に、空間光変調器に表示する位相パターンを第1パターンから回折格子パターンを含む第 2パターンに切り替えるための切替制御を行い、判定部は、切替制御の前のレーザ光の強 度から切替制御の後のレーザ光の強度を減算して強度差を計算すると共に、前記強度差が 閾値よりも大きいか否かに基づいて判定を行ってもよい。

30

20

[0010]

この場合、空間光変調器の動作が正常であれば、切替制御の後に空間光変調器に入射し たレーザ光は、第2パターンに含まれる回折格子パターンにより回折される。したがって 、一部の回折光の強度に着目すれば、切替制御の前のレーザ光の強度に比べて一定以上小 さくなる。したがって、切替制御の前後の強度差を所定の閾値と比較することにより、空 間光変調器の動作が正常であるか否かが容易且つ確実に判定可能である。

(4)

【 0 0 1 1 】

本発明に係るレーザ加工装置は、レーザ光の光路における空間光変調器と対物レンズと の間に配置され、レーザ光を集束する集束レンズと、レーザ光の光路における集束レンズ の後側の焦点位置に配置され、回折格子パターンに応じて回折されたレーザ光の一定次数 以上の回折光を遮断するスリット部材と、を備えてもよい。この場合、空間光変調器の動 作が正常であるときに、焦点位置において一定次数以上の回折光を遮断することによって 、切替制御の前後における強度差を十分に生じさせることができる。したがって、空間光 変調器の動作が正常であるか否かの判定がより容易且つ確実となる。

【0012】

本発明に係るレーザ加工装置においては、第2モードは、対物レンズから出射されたレ ーザ光の強度を測定するための計測モードであり、判定部は、レーザ光の光路における対 物レンズの後段に配置されたパワーメータにより取得されたレーザ光の強度に基づいて判 定を行ってもよい。この場合、キャリブレーションとしての計測モードを利用して、空間 光変調器の動作確認が可能となる。

[0013]

本発明に係るレーザ加工装置は、対物レンズの入射瞳面と共役な撮像面を有し、レーザ 光の画像を取得するカメラを備え、判定部は、カメラにより取得された画像に基づいて取 得されたレーザ光の強度に基づいて判定を行ってもよい。この場合、レーザ加工装置のカ メラを利用して空間光変調器の動作確認が可能となる。

【発明の効果】

【0014】

本発明によれば、加工時以外のタイミングで空間光変調器の動作確認が可能なレーザ加 工装置、及び、動作確認方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

[0015]

- 【図1】改質領域の形成に用いられるレーザ加工装置の概略構成図である。
- 【図2】改質領域の形成の対象となる加工対象物の平面図である。

【図3】図2の加工対象物の111-111線に沿っての断面図である。

【図4】レーザ加工後の加工対象物の平面図である。

【図5】図4の加工対象物のV-V線に沿っての断面図である。

【図6】図4の加工対象物のVI-VI線に沿っての断面図である。

【図7】実施形態に係るレーザ加工装置の斜視図である。

【図8】図7のレーザ加工装置の支持台に取り付けられる加工対象物の斜視図である。

【図9】図7のZX平面に沿ってのレーザ出力部の断面図である。

【図10】図7のレーザ加工装置におけるレーザ出力部及びレーザ集光部の一部の斜視図 である。

- 【図11】図7のXY平面に沿ってのレーザ集光部の断面図である。
- 【図12】図11のXII-XII線に沿ってのレーザ集光部の断面図である。
- 【図13】図12のXIII-XIII線に沿ってのレーザ集光部の断面図である。

【図14】図7のレーザ加工装置における反射型空間光変調器の部分断面図である。

【図15】図11のレーザ集光部における反射型空間光変調器、 4 f レンズユニット及び

集光レンズユニットの光学的配置関係を示す図である。

【図16】第1実施形態に係るレーザ加工装置の要部を示す概略構成図である。

【図17】回折格子パターンの一例、及び、回折光を示す図である。

20

10

30

【図18】第1実施形態に係るレーザ加工装置における動作確認方法を示すフローチャートである。 【図19】第2実施形態に係るレーザ加工装置の要部を示す概略構成図である。

【図20】第2実施形態の変形例に係るレーザ加工装置の要部を示す概略構成図であ。

【図21】回折格子パターンの別の例、及び、回折光を示す図である。

【図22】回折格子パターンの一例、及び、回折光を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0016】

以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図にお いて、互いに同一の要素、又は、互いに相当する要素には同一の符号を付し、重複する説 ¹⁰ 明を省略する場合がある。

【0017】

実施形態に係るレーザ加工装置では、加工対象物にレーザ光を集光することにより、切 断予定ラインに沿って加工対象物に改質領域を形成する。そこで、まず、改質領域の形成 について、図1~図6を参照して説明する。

【0018】

図1に示されるように、レーザ加工装置100は、レーザ光Lをパルス発振するレーザ 光源101と、レーザ光Lの光軸(光路)の向きを90°変えるように配置されたダイク ロイックミラー103と、レーザ光Lを集光するための集光用レンズ105と、を備えて いる。また、レーザ加工装置100は、集光用レンズ105で集光されたレーザ光Lが照 射される対象物である加工対象物1を支持するための支持台107と、支持台107を移 動させるための移動機構であるステージ111と、レーザ光Lの出力やパルス幅、パルス 波形等を調節するためにレーザ光源101を制御するレーザ光源制御部102と、ステー ジ1110移動を制御するステージ制御部115と、を備えている。

【0019】

レーザ加工装置100においては、レーザ光源101から出射されたレーザ光しは、ダ イクロイックミラー103によってその光軸の向きを90°変えられ、支持台107上に 載置された加工対象物1の内部に集光用レンズ105によって集光される。これと共に、 ステージ1111が移動させられ、加工対象物1がレーザ光しに対して切断予定ライン5に 沿って相対移動させられる。これにより、切断予定ライン5に沿った改質領域が加工対象 物1に形成される。なお、ここでは、レーザ光しを相対的に移動させるためにステージ1 11を移動させたが、集光用レンズ105を移動させてもよいし、或いはこれらの両方を 移動させてもよい。

【0020】

加工対象物1としては、半導体材料で形成された半導体基板や圧電材料で形成された圧 電基板等を含む板状の部材(例えば、基板、ウェハ等)が用いられる。図2に示されるよ うに、加工対象物1には、加工対象物1を切断するための切断予定ライン5が設定されて いる。切断予定ライン5は、直線状に延びた仮想線である。加工対象物1の内部に改質領 域を形成する場合、図3に示されるように、加工対象物1の内部に集光点(集光位置)P を合わせた状態で、レーザ光Lを切断予定ライン5に沿って(すなわち、図2の矢印A方 向に)相対的に移動させる。これにより、図4、図5及び図6に示されるように、改質領 域7が切断予定ライン5に沿って加工対象物1に形成され、切断予定ライン5に沿って形 成された改質領域7が切断起点領域8となる。切断予定ライン5は、照射予定ラインに対 応する。

[0021]

集光点 Pとは、レーザ光 L が集光する箇所のことである。切断予定ライン5は、直線状 に限らず曲線状であってもよいし、これらが組み合わされた3次元状であってもよいし、 座標指定されたものであってもよい。切断予定ライン5は、仮想線に限らず加工対象物1 の表面3に実際に引かれた線であってもよい。改質領域7は、連続的に形成される場合も あるし、断続的に形成される場合もある。改質領域7は列状でも点状でもよく、要は、改 20

質領域7は少なくとも加工対象物1の内部、表面3又は裏面に形成されていればよい。改 質領域7を起点に亀裂が形成される場合があり、亀裂及び改質領域7は、加工対象物1の 外表面(表面3、裏面、若しくは外周面)に露出していてもよい。改質領域7を形成する 際のレーザ光入射面は、加工対象物1の表面3に限定されるものではなく、加工対象物1 の裏面であってもよい。

(6)

【0022】

ちなみに、加工対象物1の内部に改質領域7を形成する場合には、レーザ光しは、加工 対象物1を透過すると共に、加工対象物1の内部に位置する集光点P近傍にて特に吸収さ れる。これにより、加工対象物1に改質領域7が形成される(すなわち、内部吸収型レー ザ加工)。この場合、加工対象物1の表面3ではレーザ光しが殆ど吸収されないので、加 工対象物1の表面3が溶融することはない。一方、加工対象物1の表面3又は裏面に改質 領域7を形成する場合には、レーザ光しは、表面3又は裏面に位置する集光点P近傍にて 特に吸収され、表面3又は裏面から溶融され除去されて、穴や溝等の除去部が形成される (表面吸収型レーザ加工)。

【0023】

改質領域7は、密度、屈折率、機械的強度やその他の物理的特性が周囲とは異なる状態 になった領域をいう。改質領域7としては、例えば、溶融処理領域(一旦溶融後再固化し た領域、溶融状態中の領域及び溶融から再固化する状態中の領域のうち少なくとも何れか 一つを意味する)、クラック領域、絶縁破壊領域、屈折率変化領域等があり、これらが混 在した領域もある。更に、改質領域7としては、加工対象物1の材料において改質領域7 の密度が非改質領域の密度と比較して変化した領域や、格子欠陥が形成された領域がある 。加工対象物1の材料が単結晶シリコンである場合、改質領域7は、高転位密度領域とも いえる。

【0024】

溶融処理領域、屈折率変化領域、改質領域7の密度が非改質領域の密度と比較して変化 した領域、及び、格子欠陥が形成された領域は、更に、それら領域の内部や改質領域7と 非改質領域との界面に亀裂(割れ、マイクロクラック)を内包している場合がある。内包 される亀裂は、改質領域7の全面に渡る場合や一部分のみや複数部分に形成される場合が ある。加工対象物1は、結晶構造を有する結晶材料からなる基板を含む。例えば加工対象 物1は、窒化ガリウム(GaN)、シリコン(Si)、シリコンカーバイド(SiC)、 LiTaO3、及び、サファイア(Al2O3)の少なくとも何れかで形成された基板を 含む。換言すると、加工対象物1は、例えば、窒化ガリウム基板、シリコン基板、SiC 基板、LiTaO3基板、又はサファイア基板を含む。結晶材料は、異方性結晶及び等方 性結晶の何れであってもよい。また、加工対象物1は、非結晶構造(非晶質構造)を有す る非結晶材料からなる基板を含んでいてもよく、例えばガラス基板を含んでいてもよい。 【0025】

実施形態では、切断予定ライン5に沿って改質スポット(加工痕)を複数形成すること により、改質領域7を形成することができる。この場合、複数の改質スポットが集まるこ とによって改質領域7となる。改質スポットとは、パルスレーザ光の1パルスのショット (つまり1パルスのレーザ照射:レーザショット)で形成される改質部分である。改質ス ポットとしては、クラックスポット、溶融処理スポット若しくは屈折率変化スポット、又 はこれらの少なくとも1つが混在するもの等が挙げられる。改質スポットについては、要 求される切断精度、要求される切断面の平坦性、加工対象物1の厚さ、種類、結晶方位等 を考慮して、その大きさや発生する亀裂の長さを適宜制御することができる。また、実施 形態では、切断予定ライン5に沿って、改質スポットを改質領域7として形成することが できる。

[実施形態に係るレーザ加工装置]

[0026]

次に、実施形態に係るレーザ加工装置について説明する。以下の説明では、水平面内に おいて互いに直交する方向をX軸方向及びY軸方向とし、鉛直方向をZ軸方向とする。 10

20

30

40

[レーザ加工装置の全体構成]

【0027】

図7に示されるように、レーザ加工装置200は、装置フレーム210と、第1移動機 構(移動機構)220と、支持台230と、第2移動機構240と、を備えている。さら に、レーザ加工装置200は、レーザ出力部300と、レーザ集光部400と、制御部5 00と、を備えている。

(7)

【0028】

第1移動機構220は、装置フレーム210に取り付けられている。第1移動機構22 0は、第1レールユニット221と、第2レールユニット222と、可動ベース223と 、を有している。第1レールユニット221は、装置フレーム210に取り付けられてい る。第1レールユニット221には、Y軸方向に沿って延在する一対のレール221a, 221bが設けられている。第2レールユニット222は、Y軸方向に沿って移動可能と なるように、第1レールユニット22210一対のレール221a,221bに取り付けら れている。第2レールユニット222には、X軸方向に沿って延在する一対のレール22 2a,222bが設けられている。可動ベース223は、X軸方向に沿って移動可能とな るように、第2レールユニット2220一対のレール222a,222bに取り付けられ ている。可動ベース223は、Z軸方向に平行な軸線を中心線として回転可能である。 【0029】

支持台230は、可動ベース223に取り付けられている。支持台230は、加工対象 物1を支持する。加工対象物1は、例えば、シリコン等の半導体材料からなる基板の表面 側に複数の機能素子(フォトダイオード等の受光素子、レーザダイオード等の発光素子、 又は回路として形成された回路素子等)がマトリックス状に形成されたものである。加工 対象物1が支持台230に支持される際には、図8に示されるように、環状のフレーム1 1に張られたフィルム12上に、例えば加工対象物1の表面1a(複数の機能素子側の面)が貼付される。支持台230は、クランプによってフレーム11を保持すると共に真空 チャックテーブルによってフィルム12を吸着することで、加工対象物1を支持する。支 持台230上において、加工対象物1には、互いに平行な複数の切断予定ライン5a、及 び互いに平行な複数の切断予定ライン5bが、隣り合う機能素子の間を通るように格子状 に設定される。

【 0 0 3 0 】

図7に示されるように、支持台230は、第1移動機構220において第2レールユニ ット222が動作することで、Y軸方向に沿って移動させられる。また、支持台230は 、第1移動機構220において可動ベース223が動作することで、X軸方向に沿って移 動させられる。更に、支持台230は、第1移動機構220において可動ベース223が 動作することで、Z軸方向に平行な軸線を中心線として回転させられる。このように、支 持台230は、X軸方向及びY軸方向に沿って移動可能となり且つZ軸方向に平行な軸線 を中心線として回転可能となるように、装置フレーム210に取り付けられている。 【0031】

レーザ出力部300は、装置フレーム210に取り付けられている。レーザ集光部40 0は、第2移動機構240を介して装置フレーム210に取り付けられている。レーザ集 光部400は、第2移動機構240が動作することで、Z軸方向に沿って移動させられる 。このように、レーザ集光部400は、レーザ出力部300に対してZ軸方向に沿って移 動可能となるように、装置フレーム210に取り付けられている。

【0032】

制御部500は、CPU (Central Processing Unit)、ROM (Read Only Memory)及びRAM (Random Access Memory)等によって構成されている。制御部500は、レーザ加工装置200の各部の動作を制御する。

[0033]

ー例として、レーザ加工装置200では、次のように、各切断予定ライン5a,5b(図8参照)に沿って加工対象物1の内部に改質領域が形成される。 10

30

20

40

[0034]

まず、加工対象物1の裏面1b(図8参照)がレーザ光入射面となるように、加工対象 物1が支持台230に支持され、加工対象物1の各切断予定ライン5aがX軸方向に平行 な方向に合わせられる。続いて、加工対象物1の内部において加工対象物1のレーザ光入 射面から所定距離だけ離間した位置にレーザ光Lの集光点が位置するように、第2移動機 構240によってレーザ集光部400が移動させられる。続いて、加工対象物1のレーザ 光入射面とレーザ光Lの集光点との距離が一定に維持されつつ、各切断予定ライン5aに 沿ってレーザ光Lの集光点が相対的に移動させられる。これにより、各切断予定ライン5 aに沿って加工対象物1の内部に改質領域が形成される。

(8)

[0035]

各切断予定ライン5aに沿っての改質領域の形成が終了すると、第1移動機構220に よって支持台230が回転させられ、加工対象物1の各切断予定ライン5bがX軸方向に 平行な方向に合わせられる。続いて、加工対象物1の内部において加工対象物1のレーザ 光入射面から所定距離だけ離間した位置にレーザ光Lの集光点が位置するように、第2移 動機構240によってレーザ集光部400が移動させられる。続いて、加工対象物1のレ ーザ光入射面とレーザ光Lの集光点との距離が一定に維持されつつ、各切断予定ライン5 bに沿ってレーザ光Lの集光点が相対的に移動させられる。これにより、各切断予定ライ ン5bに沿って加工対象物1の内部に改質領域が形成される。

[0036]

20 このように、レーザ加工装置200では、X軸方向に平行な方向が加工方向(レーザ光 Lのスキャン方向)とされている。なお、各切断予定ライン5aに沿ったレーザ光Lの集 光点の相対的な移動、及び各切断予定ライン5bに沿ったレーザ光Lの集光点の相対的な 移動は、第1移動機構220によって支持台230がX軸方向に沿って移動させられるこ とで、実施される。また、各切断予定ライン5a間におけるレーザ光Lの集光点の相対的 な移動、及び各切断予定ライン5b間におけるレーザ光Lの集光点の相対的な移動は、第 1移動機構220によって支持台230がY軸方向に沿って移動させられることで、実施 される。

[0037]

図9に示されるように、レーザ出力部300は、取付ベース301と、カバー302と 、複数のミラー303,304と、を有している。更に、レーザ出力部300は、レーザ 発振器(レーザ光源)310と、シャッタ320と、 /2波長板ユニット330と、偏 光板ユニット340と、ビームエキスパンダ350と、ミラーユニット360と、を有し ている。

[0038]

取付ベース301は、複数のミラー303,304、レーザ発振器310、シャッタ3 20、 / 2 波長板ユニット330、偏光板ユニット340、ビームエキスパンダ350 及びミラーユニット360を支持している。複数のミラー303,304、レーザ発振器 310、シャッタ320、 /2波長板ユニット330、偏光板ユニット340、ビーム エキスパンダ350及びミラーユニット360は、取付ベース301の主面301aに取 り付けられている。取付ベース301は、板状の部材であり、装置フレーム210(図7 参照)に対して着脱可能である。レーザ出力部300は、取付ベース301を介して装置 フレーム210に取り付けられている。つまり、レーザ出力部300は、装置フレーム2 10に対して着脱可能である。

【0039】

カバー302は、取付ベース301の主面301a上において、複数のミラー303, 304、レーザ発振器310、シャッタ320、 /2波長板ユニット330、偏光板ユ ニット340、ビームエキスパンダ350及びミラーユニット360を覆っている。カバ - 3 0 2 は、取付ベース 3 0 1 に対して着脱可能である。

[0040]

レーザ発振器310は、直線偏光のレーザ光LをX軸方向に沿ってパルス発振する。レ 50

30

ーザ発振器310から出射されるレーザ光Lの波長は、500~550nm、1000~ 1150nm又は1300~1400nmのいずれかの波長帯に含まれる。500~55 0nmの波長帯のレーザ光Lは、例えばサファイアからなる基板に対する内部吸収型レー ザ加工に適している。1000~1150nm及び1300~1400nmの各波長帯の レーザ光Lは、例えばシリコンからなる基板に対する内部吸収型レーザ加工に適している。 、レーザ発振器310から出射されるレーザ光Lの偏光方向は、例えば、Y軸方向に平行 な方向である。レーザ発振器310から出射されたレーザ光Lは、ミラー303によって 反射され、Y軸方向に沿ってシャッタ320に入射する。

【0041】

レーザ発振器310では、次のように、レーザ光Lの出力のON/OFFが切り替えら ¹⁰ れる。レーザ発振器310が固体レーザで構成されている場合、共振器内に設けられたQ スイッチ(AOM(音響光学変調器)、EOM(電気光学変調器)等)のON/OFFが 切り替えられることで、レーザ光Lの出力のON/OFFが高速に切り替えられる。レー ザ発振器310がファイバレーザで構成されている場合、シードレーザ、アンプ(励起用)レーザを構成する半導体レーザの出力のON/OFFが切り替えられることで、レーザ 光Lの出力のON/OFFが高速に切り替えられる。レーザ発振器310が外部変調素子 を用いている場合、共振器外に設けられた外部変調素子(AOM、EOM等)のON/O FFが切り替えられることで、レーザ光Lの出力のON/OFFが高速に切り替えられる

【0042】

シャッタ320は、機械式の機構によってレーザ光Lの光路を開閉する。レーザ出力部 300からのレーザ光Lの出力のON/OFFの切り替えは、上述したように、レーザ発 振器310でのレーザ光Lの出力のON/OFFの切り替えによって実施されるが、シャ ッタ320が設けられていることで、例えばレーザ出力部300からレーザ光Lが不意に 出射されることが防止される。シャッタ320を通過したレーザ光Lは、ミラー304に よって反射され、X軸方向に沿って /2波長板ユニット330及び偏光板ユニット34 0に順次入射する。

【0043】

/2波長板ユニット330及び偏光板ユニット340は、レーザ光Lの出力(光強度)を調整する出力調整部として機能する。また、 /2波長板ユニット330及び偏光板 ユニット340は、レーザ光Lの偏光方向を調整する偏光方向調整部として機能する。 /2波長板ユニット330及び偏光板ユニット340を順次通過したレーザ光Lは、X軸 方向に沿ってビームエキスパンダ350に入射する。

[0044]

ビームエキスパンダ350は、レーザ光Lの径を調整しつつ、レーザ光Lを平行化する。ビームエキスパンダ350を通過したレーザ光Lは、X軸方向に沿ってミラーユニット 360に入射する。

【0045】

ミラーユニット360は、支持ベース361と、複数のミラー362,363と、を有 している。支持ベース361は、複数のミラー362,363を支持している。支持ベー ス361は、X軸方向及びY軸方向に沿って位置調整可能となるように、取付ベース30 1に取り付けられている。ミラー(第1ミラー)362は、ビームエキスパンダ350を 通過したレーザ光LをY軸方向に反射する。ミラー362は、その反射面が例えばZ軸に 平行な軸線回りに角度調整可能となるように、支持ベース361に取り付けられている。

ミラー(第2ミラー)363は、ミラー362によって反射されたレーザ光LをZ軸方向に反射する。ミラー363は、その反射面が例えばX軸に平行な軸線回りに角度調整可能となり且つY軸方向に沿って位置調整可能となるように、支持ベース361に取り付けられている。ミラー363によって反射されたレーザ光Lは、支持ベース361に形成された開口361aを通過し、Z軸方向に沿ってレーザ集光部400(図7参照)に入射す

20

30

る。つまり、レーザ出力部300によるレーザ光Lの出射方向は、レーザ集光部400の 移動方向に一致している。上述したように、各ミラー362,363は、反射面の角度を 調整するための機構を有している。

【0047】

ミラーユニット360では、取付ベース301に対する支持ベース361の位置調整、 支持ベース361に対するミラー363の位置調整、及び各ミラー362,363の反射 面の角度調整が実施されることで、レーザ出力部300から出射されるレーザ光Lの光軸 の位置及び角度がレーザ集光部400に対して合わされる。つまり、複数のミラー362 ,363は、レーザ出力部300から出射されるレーザ光Lの光軸を調整するための構成 である。

【0048】

図10に示されるように、レーザ集光部400は、筐体401を有している。筐体40 1は、Y軸方向を長手方向とする直方体状の形状を呈している。筐体401の一方の側面 401eには、第2移動機構240が取り付けられている(図11及び図13参照)。筐 体401には、ミラーユニット360の開口361aとZ軸方向において対向するように 、円筒状の光入射部401aが設けられている。光入射部401aは、レーザ出力部30 0から出射されたレーザ光Lを筐体401内に入射させる。ミラーユニット360と光入 射部401aとは、第2移動機構240によってレーザ集光部400がZ軸方向に沿って 移動させられた際に互いに接触することがない距離だけ、互いに離間している。 【0049】

図11及び図12に示されるように、レーザ集光部400は、ミラー402と、ダイク ロイックミラー403と、を有している。更に、レーザ集光部400は、反射型空間光変 調器410と、4fレンズユニット420と、集光レンズユニット(対物レンズ)430 と、駆動機構440と、一対の測距センサ450と、を有している。

【 0 0 5 0 】

ミラー402は、光入射部401aとZ軸方向において対向するように、筐体401の 底面401bに取り付けられている。ミラー402は、光入射部401aを介して筐体4 01内に入射したレーザ光LをXY平面に平行な方向に反射する。ミラー402には、レ ーザ出力部300のビームエキスパンダ350によって平行化されたレーザ光LがZ軸方 向に沿って入射する。つまり、ミラー402には、レーザ光Lが平行光としてZ軸方向に 沿って入射する。そのため、第2移動機構240によってレーザ集光部400がZ軸方向 に沿って移動させられても、Z軸方向に沿ってミラー402に入射するレーザ光Lの状態 は一定に維持される。ミラー402によって反射されたレーザ光Lは、反射型空間光変調 器410に入射する。

[0051]

反射型空間光変調器410は、反射面410aが筐体401内に臨んだ状態で、Y軸方向における筐体401の端部401cに取り付けられている。反射型空間光変調器410 は、例えば反射型液晶(LCOS:Liquid Crystal on Silicon)の空間光変調器(S LM:Spatial Light Modulator)であり、レーザ光Lを変調しつつ、レーザ光LをY 軸方向に反射する。反射型空間光変調器410によって変調されると共に反射されたレー ザ光Lは、Y軸方向に沿って4fレンズユニット420に入射する。ここで、XY平面に 平行な平面内において、反射型空間光変調器410に入射するレーザ光Lの光軸と、反射 型空間光変調器410から出射されるレーザ光Lの光軸とがなす角度 は、鋭角(例えば 、10~60°)とされている。つまり、レーザ光Lは、反射型空間光変調器410にお いてXY平面に沿って鋭角に反射される。これは、レーザ光Lの入射角及び反射角を抑え て回折効率の低下を抑制し、反射型空間光変調器410の性能を十分に発揮させるためで ある。なお、反射型空間光変調器410では、例えば、液晶が用いられた光変調層の厚さ が数µm~数+µm程度と極めて薄いため、反射面410aは、光変調層の光入出射面と 実質的に同じと捉えることができる。

[0052]

10

20

4 f レンズユニット420は、ホルダ421と、反射型空間光変調器410側のレンズ 422と、集光レンズユニット430側のレンズ423と、スリット部材424と、を有 している。ホルダ421は、一対のレンズ422,423及びスリット部材424を保持 している。ホルダ421は、レーザ光Lの光軸に沿った方向における一対のレンズ422 ,423及びスリット部材424の互いの位置関係を一定に維持している。一対のレンズ 422,423は、反射型空間光変調器410の反射面410aと集光レンズユニット4 30の入射瞳面(瞳面)430aとが結像関係にある両側テレセントリック光学系を構成 している。

(11)

【0053】

これにより、反射型空間光変調器410の反射面410aでのレーザ光Lの像(反射型 10 空間光変調器410において変調されたレーザ光Lの像)が、集光レンズユニット430 の入射瞳面430aに転像(結像)される。スリット部材424には、スリット424a が形成されている。スリット424aは、レンズ422とレンズ423との間であって、 レンズ422の焦点面付近に位置している。反射型空間光変調器410によって変調され ると共に反射されたレーザ光Lのうち不要な部分は、スリット部材424によって遮断さ れる。4fレンズユニット420を通過したレーザ光Lは、Y軸方向に沿ってダイクロイ ックミラー403に入射する。

【0054】

ダイクロイックミラー403は、レーザ光Lの大部分(例えば、95~99.5%)を Z軸方向に反射し、レーザ光Lの一部(例えば、0.5~5%)をY軸方向に沿って透過 20 させる。レーザ光Lの大部分は、ダイクロイックミラー403においてZX平面に沿って 直角に反射される。ダイクロイックミラー403によって反射されたレーザ光Lは、Z軸 方向に沿って集光レンズユニット430に入射する。

【0055】

集光レンズユニット430は、Y軸方向における筐体401の端部401d(端部40 1 cの反対側の端部)に、駆動機構440を介して取り付けられている。集光レンズユニ ット430は、ホルダ431と、複数のレンズ432と、を有している。ホルダ431は 、複数のレンズ432を保持している。複数のレンズ432は、支持台230に支持され た加工対象物1(図7参照)に対してレーザ光Lを集光する。駆動機構440は、圧電素 子の駆動力によって、集光レンズユニット430をZ軸方向に沿って移動させる。 【0056】

ー対の測距センサ450は、X軸方向において集光レンズユニット430の両側に位置 するように、筐体401の端部401dに取り付けられている。各測距センサ450は、 支持台230に支持された加工対象物1(図7参照)のレーザ光入射面に対して測距用の 光(例えば、レーザ光)を出射し、当該レーザ光入射面によって反射された測距用の光を 検出することで、加工対象物1のレーザ光入射面の変位データを取得する。なお、測距セ ンサ450には、三角測距方式、レーザ共焦点方式、白色共焦点方式、分光干渉方式、非 点収差方式等のセンサを利用することができる。

[0057]

レーザ加工装置200では、上述したように、X軸方向に平行な方向が加工方向(レー ザ光Lのスキャン方向)とされている。そのため、各切断予定ライン5a,5bに沿って レーザ光Lの集光点が相対的に移動させられる際に、一対の測距センサ450のうち集光 レンズユニット430に対して相対的に先行する測距センサ450が、各切断予定ライン 5a,5bに沿った加工対象物1のレーザ光入射面の変位データを取得する。そして、加 工対象物1のレーザ光入射面とレーザ光Lの集光点との距離が一定に維持されるように、 駆動機構440が、測距センサ450によって取得された変位データに基づいて集光レン ズユニット430をZ軸方向に沿って移動させる。

【0058】

レーザ集光部400は、ビームスプリッタ461と、一対のレンズ462,463と、 プロファイル取得用カメラ(強度分布取得部)464と、を有している。ビームスプリッ ⁵⁰

タ461は、ダイクロイックミラー403を透過したレーザ光Lを反射成分と透過成分と に分ける。ビームスプリッタ461によって反射されたレーザ光Lは、Z軸方向に沿って ー対のレンズ462,463及びプロファイル取得用カメラ464に順次入射する。一対 のレンズ462,463は、集光レンズユニット430の入射瞳面430aとプロファイ ル取得用カメラ464の撮像面とが結像関係にある両側テレセントリック光学系を構成し ている。これにより、集光レンズユニット430の入射瞳面430aでのレーザ光Lの像 が、プロファイル取得用カメラ464の撮像面に転像(結像)される。上述したように、 集光レンズユニット430の入射瞳面430aでのレーザ光Lの像は、反射型空間光変調 器410において変調されたレーザ光Lの像である。したがって、レーザ加工装置200 では、プロファイル取得用カメラ464による撮像結果を監視することで、反射型空間光 変調器410の動作状態を把握することができる。

【0059】

更に、レーザ集光部400は、ビームスプリッタ471と、レンズ472と、レーザ光 Lの光軸位置モニタ用のカメラ473と、を有している。ビームスプリッタ471は、ビ ームスプリッタ461を透過したレーザ光Lを反射成分と透過成分とに分ける。ビームス プリッタ471によって反射されたレーザ光Lは、Z軸方向に沿ってレンズ472及びカ メラ473に順次入射する。レンズ472は、入射したレーザ光Lをカメラ473の撮像 面上に集光する。レーザ加工装置200では、カメラ464及びカメラ473のそれぞれ による撮像結果を監視しつつ、ミラーユニット360において、取付ベース301に対す る支持ベース361の位置調整、支持ベース361に対するミラー363の位置調整、及 び各ミラー362,363の反射面の角度調整を実施することで(図9及び図10参照) 、集光レンズユニット430に入射するレーザ光Lの光軸のずれ(集光レンズユニット4 30に対するレーザ光の強度分布の位置ずれ、及び集光レンズユニット430に対するレ ーザ光Lの光軸の角度ずれ)を補正することができる。

【 0 0 6 0 】

複数のビームスプリッタ461,471は、筐体401の端部401dからY軸方向に 沿って延在する筒体404内に配置されている。一対のレンズ462,463は、Z軸方 向に沿って筒体404上に立設された筒体405内に配置されており、プロファイル取得 用カメラ464は、筒体405の端部に配置されている。レンズ472は、Z軸方向に沿 って筒体404上に立設された筒体406内に配置されており、カメラ473は、筒体4 06の端部に配置されている。筒体405と筒体406とは、Y軸方向において互いに並 設されている。なお、ビームスプリッタ471を透過したレーザ光Lは、筒体404の端 部に設けられたダンパ等に吸収されるようにしてもよいし、或いは、適宜の用途で利用さ れるようにしてもよい。

[0061]

図12及び図13に示されるように、レーザ集光部400は、可視光源481と、複数 のレンズ482と、レチクル483と、ミラー484と、ハーフミラー485と、ビーム スプリッタ486と、レンズ487と、観察カメラ488と、を有している。可視光源4 81は、Z軸方向に沿って可視光Vを出射する。複数のレンズ482は、可視光源481 から出射された可視光Vを平行化する。レチクル483は、可視光Vに目盛り線を付与す る。ミラー484は、複数のレンズ482によって平行化された可視光VをX軸方向に反 射する。ハーフミラー485は、ミラー484によって反射された可視光Vを反射成分と 透過成分とに分ける。ハーフミラー485によって反射された可視光Vは、Z軸方向に沿 ってビームスプリッタ486及びダイクロイックミラー403を順次透過し、集光レンズ ユニット430を介して、支持台230に支持された加工対象物1(図7参照)に照射さ れる。

[0062]

加工対象物1に照射された可視光Vは、加工対象物1のレーザ光入射面によって反射され、集光レンズユニット430を介してダイクロイックミラー403に入射し、Z軸方向 に沿ってダイクロイックミラー403を透過する。ビームスプリッタ486は、ダイクロ

10

20

イックミラー403を透過した可視光Vを反射成分と透過成分とに分ける。ビームスプリッタ486を透過した可視光Vは、ハーフミラー485を透過し、Z軸方向に沿ってレンズ487及び観察カメラ488に順次入射する。レンズ487は、入射した可視光Vを観察カメラ488の撮像面上に集光する。レーザ加工装置200では、観察カメラ488による撮像結果を観察することで、加工対象物1の状態を把握することができる。

ミラー484、ハーフミラー485及びビームスプリッタ486は、筐体401の端部 401d上に取り付けられたホルダ407内に配置されている。複数のレンズ482及び レチクル483は、Z軸方向に沿ってホルダ407上に立設された筒体408内に配置さ れており、可視光源481は、筒体408の端部に配置されている。レンズ487は、Z 軸方向に沿ってホルダ407上に立設された筒体409内に配置されており、観察カメラ 488は、筒体409の端部に配置されている。筒体408と筒体409とは、X軸方向 において互いに並設されている。なお、X軸方向に沿ってハーフミラー485を透過した 可視光V、及びビームスプリッタ486によってX軸方向に反射された可視光Vは、それ ぞれ、ホルダ407の壁部に設けられたダンパ等に吸収されるようにしてもよいし、或い は、適宜の用途で利用されるようにしてもよい。

【0064】

レーザ加工装置200では、レーザ出力部300の交換が想定されている。これは、加 工対象物1の仕様、加工条件等に応じて、加工に適したレーザ光Lの波長が異なるからで ある。そのため、出射するレーザ光Lの波長が互いに異なる複数のレーザ出力部300が 用意される。ここでは、出射するレーザ光Lの波長が500~550 nmの波長帯に含ま れるレーザ出力部300、出射するレーザ光Lの波長が1000~1150 nmの波長帯 に含まれるレーザ出力部300、及び出射するレーザ光Lの波長が1300~1400 n mの波長帯に含まれるレーザ出力部300が用意される。

【0065】

一方、レーザ加工装置200では、レーザ集光部400の交換が想定されていない。これは、レーザ集光部400がマルチ波長に対応している(互いに連続しない複数の波長帯に対応している)からである。具体的には、ミラー402、反射型空間光変調器410、4fレンズユニット420の一対のレンズ422,423、ダイクロイックミラー403、及び集光レンズユニット430のレンズ432等がマルチ波長に対応している。
【0066】

ここでは、レーザ集光部400は、500~550nm、1000~1150nm及び 1300~1400nmの波長帯に対応している。これは、レーザ集光部400の各構成 に所定の誘電体多層膜をコーティングすること等、所望の光学性能が満足されるようにレ ーザ集光部400の各構成が設計されることで実現される。なお、レーザ出力部300に おいて、 / 2 波長板ユニット330は / 2 波長板を有しており、偏光板ユニット34 0は偏光板を有している。 / 2 波長板及び偏光板は、波長依存性が高い光学素子である 。そのため、 / 2 波長板ユニット330及び偏光板ユニット340は、波長帯ごとに異 なる構成としてレーザ出力部300に設けられている。

[レーザ加工装置におけるレーザ光の光路及び偏光方向]

【0067】

レーザ加工装置200では、支持台230に支持された加工対象物1に対して集光され るレーザ光Lの偏光方向は、図11に示されるように、X軸方向に平行な方向であり、加 工方向(レーザ光Lのスキャン方向)に一致している。ここで、反射型空間光変調器41 0では、レーザ光LがP偏光として反射される。これは、反射型空間光変調器410の光 変調層に液晶が用いられている場合において、反射型空間光変調器410に対して入出射 するレーザ光Lの光軸を含む平面に平行な面内で液晶分子が傾斜するように、当該液晶が 配向されているときには、偏波面の回転が抑制された状態でレーザ光Lに位相変調が施さ れるからである(例えば、特許第3878758号公報参照)。 【0068】 10



ー方、ダイクロイックミラー403では、レーザ光LがS偏光として反射される。これ は、レーザ光LをP偏光として反射させるよりも、レーザ光LをS偏光として反射させた ほうが、ダイクロイックミラー403をマルチ波長に対応させるための誘電体多層膜のコ ーティング数が減少する等、ダイクロイックミラー403の設計が容易となるからである

【0069】

したがって、レーザ集光部400では、ミラー402から反射型空間光変調器410及 び4 f レンズユニット420を介してダイクロイックミラー403に至る光路が、XY平 面に沿うように設定されており、ダイクロイックミラー403から集光レンズユニット4 30に至る光路が、Z軸方向に沿うように設定されている。

【0070】

図9に示されるように、レーザ出力部300では、レーザ光Lの光路がX軸方向又はY 軸方向に沿うように設定されている。具体的には、レーザ発振器310からミラー303 に至る光路、並びに、ミラー304から / 2波長板ユニット330、偏光板ユニット3 40及びビームエキスパンダ350を介してミラーユニット360に至る光路が、X軸方 向に沿うように設定されており、ミラー303からシャッタ320を介してミラー304 に至る光路、及び、ミラーユニット360においてミラー362からミラー363に至る 光路が、Y軸方向に沿うように設定されている。

[0071]

ここで、Z軸方向に沿ってレーザ出力部300からレーザ集光部400に進行したレー²⁰ ザ光Lは、図11に示されるように、ミラー402によってXY平面に平行な方向に反射 され、反射型空間光変調器410に入射する。このとき、XY平面に平行な平面内におい て、反射型空間光変調器410に入射するレーザ光Lの光軸と、反射型空間光変調器41 0から出射されるレーザ光Lの光軸とは、鋭角である角度をなしている。一方、上述し たように、レーザ出力部300では、レーザ光Lの光路がX軸方向又はY軸方向に沿うよ うに設定されている。

[0072]

したがって、レーザ出力部300において、 /2波長板ユニット330及び偏光板ユニット340を、レーザ光Lの出力を調整する出力調整部としてだけでなく、レーザ光L の偏光方向を調整する偏光方向調整部としても機能させる必要がある。 「反射型空間光変調器〕

【0073】

図14に示されるように、反射型空間光変調器410は、シリコン基板213、駆動回路層914、複数の画素電極214、誘電体多層膜ミラー等の反射膜215、配向膜99 9a、液晶層(表示部)216、配向膜999b、透明導電膜217、及びガラス基板等 の透明基板218がこの順に積層されることで構成されている。

【0074】

透明基板218は、表面218aを有しており、この表面218aは、反射型空間光変 調器410の反射面410aを構成している。透明基板218は、例えばガラス等の光透 過性材料からなり、反射型空間光変調器410の表面218aから入射した所定波長のレ ーザ光Lを、反射型空間光変調器410の内部へ透過する。透明導電膜217は、透明基 板218の裏面上に形成されており、レーザ光Lを透過する導電性材料(例えばITO) からなる。

【 0 0 7 5 】

複数の画素電極214は、透明導電膜217に沿ってシリコン基板213上にマトリックス状に配列されている。各画素電極214は、例えばアルミニウム等の金属材料からなり、これらの表面214aは、平坦且つ滑らかに加工されている。複数の画素電極214 は、駆動回路層914に設けられたアクティブ・マトリクス回路によって駆動される。 【0076】

アクティブ・マトリクス回路は、複数の画素電極214とシリコン基板213との間に 50

40

設けられており、反射型空間光変調器410から出力しようとする光像に応じて各画素電 極214への印加電圧を制御する。このようなアクティブ・マトリクス回路は、例えば図 示しないX軸方向に並んだ各画素列の印加電圧を制御する第1ドライバ回路と、Y軸方向 に並んだ各画素列の印加電圧を制御する第2ドライバ回路とを有しており、制御部500 0における後述の空間光変調器制御部502(図16参照)によって双方のドライバ回路 で指定された画素の画素電極214に所定電圧が印加されるように構成されている。 【0077】

(15)

配向膜999a,999bは、液晶層216の両端面に配置されており、液晶分子群を 一定方向に配列させる。配向膜999a,999bは、例えばポリイミド等の高分子材料 からなり、液晶層216との接触面にラビング処理等が施されている。

【0078】

液晶層216は、複数の画素電極214と透明導電膜217との間に配置されており、 各画素電極214と透明導電膜217とにより形成される電界に応じてレーザ光Lを変調 する。すなわち、駆動回路層914のアクティブ・マトリクス回路によって各画素電極2 14に電圧が印加されると、透明導電膜217と各画素電極214との間に電界が形成さ れ、液晶層216に形成された電界の大きさに応じて液晶分子216aの配列方向が変化 する。そして、レーザ光Lが透明基板218及び透明導電膜217を透過して液晶層21 6に入射すると、このレーザ光Lは、液晶層216を通過する間に液晶分子216aによ って変調され、反射膜215において反射した後、再び液晶層216により変調されて、 出射する。

【0079】

このとき、後述の空間光変調器制御部502(図16参照)によって各画素電極214 に印加される電圧が制御され、その電圧に応じて、液晶層216において透明導電膜21 7と各画素電極214とに挟まれた部分の屈折率が変化する(各画素に対応した位置の液 晶層216の屈折率が変化する)。この屈折率の変化により、印加した電圧に応じて、レ ーザ光Lの位相を液晶層216の画素ごとに変化させることができる。つまり、ホログラ ムパターンに応じた位相変調を画素ごとに液晶層216によって付与することができる。 【0080】

換言すると、変調を付与するホログラムパターンとしての変調パターンを、反射型空間 光変調器410の液晶層216に表示させることができる。変調パターンに入射し透過す るレーザ光Lは、その波面が調整され、そのレーザ光Lを構成する各光線において進行方 向に直交する所定方向の成分の位相にずれが生じる。したがって、反射型空間光変調器4 10に表示させる変調パターンを適宜設定することにより、レーザ光Lが変調(例えば、 レーザ光Lの強度、振幅、位相、偏光等が変調)可能となる。

[4fレンズユニット]

【0081】

上述したように、4 f レンズユニット420の一対のレンズ422,423は、反射型 空間光変調器410の反射面410aと集光レンズユニット430の入射瞳面430aと が結像関係にある両側テレセントリック光学系を構成している。具体的には、図15に示 されるように、反射型空間光変調器410側のレンズ422の中心と反射型空間光変調器 410の反射面410aとの間の光路の距離がレンズ422の第1焦点距離f1となり、 集光レンズユニット430側のレンズ423の中心と集光レンズユニット430の入射瞳 面430aとの間の光路の距離がレンズ4230第2焦点距離f2となり、レンズ422 の中心とレンズ423の中心との間の光路の距離が第1焦点距離f1と第2焦点距離f2 との和(すなわち、f1+f2)となっている。反射型空間光変調器410から集光レン ズユニット430に至る光路のうちー対のレンズ422,423間の光路は、一直線であ る。

[0082]

レーザ加工装置200では、反射型空間光変調器410の反射面410aでのレーザ光 Lの有効径を大きくする観点から、両側テレセントリック光学系の倍率Mが、0.5<M ⁵⁰

20



<1(縮小系)を満たしている。反射型空間光変調器410の反射面410aでのレーザ 光Lの有効径が大きいほど、高精細な位相パターンでレーザ光Lが変調される。反射型空 間光変調器410から集光レンズユニット430に至るレーザ光Lの光路が長くなるのを 抑制するという観点では、0.6 M 0.95であることがより好ましい。ここで、(両側テレセントリック光学系の倍率M)=(集光レンズユニット430の入射瞳面430 aでの像の大きさ)/(反射型空間光変調器410の反射面410aでの物体の大きさ) である。レーザ加工装置200の場合、両側テレセントリック光学系の倍率M、レンズ4 22の第1焦点距離f1及びレンズ423の第2焦点距離f2が、M=f2/f1を満た している。

【0083】

なお、反射型空間光変調器410の反射面410aでのレーザ光Lの有効径を小さくす る観点から、両側テレセントリック光学系の倍率Mが、1 < M < 2 (拡大系)を満たして いてもよい。反射型空間光変調器410の反射面410aでのレーザ光Lの有効径が小さ いほど、ビームエキスパンダ350(図9参照)の倍率が小さくて済み、XY平面に平行 な平面内において、反射型空間光変調器410に入射するレーザ光Lの光軸と、反射型空 間光変調器410から出射されるレーザ光Lの光軸とがなす角度 (図11参照)が小さ くなる。反射型空間光変調器410から集光レンズユニット430に至るレーザ光Lの光 路が長くなるのを抑制するという観点では、1.05 M 1.7であることがより好ま しい。

【0084】

次に、第1実施形態に係るレーザ加工装置200の要部について詳細に説明する。 【0085】

図16は、第1実施形態に係るレーザ加工装置200の要部を示す概略構成図である。 レーザ出力部300(レーザ発振器310)から出力されたレーザ光Lは、図16に示さ れるように、反射型空間光変調器410に入射する。反射型空間光変調器410は、入射 されたレーザ光Lを、液晶層216に表示された位相パターンに応じて変調して出射する 。反射型空間光変調器410から出射したレーザ光Lは、4fレンズユニット420のリ レーレンズであるレンズ(集束レンズ)422で集束された後、4fレンズユニット42 0のリレーレンズであるレンズ423でコリメートされて、ダイクロイックミラー403 に入射する。ダイクロイックミラー403に入射したレーザ光Lは、反射光と透過光とに 分岐される。ダイクロイックミラー403で反射したレーザ光Lは、集光レンズユニット 430に入射する。

[0086]

すなわち、レーザ加工装置200は、レーザ光Lの光路における反射型空間光変調器4 10と集光レンズユニット430との間に配置されたレンズ422を備えている。集光レ ンズユニット430に入射したレーザ光Lは、集光レンズユニット430により集光され る。一方、ダイクロイックミラー403を透過したレーザ光Lは、リレーレンズである上 記レンズ463で集束され、プロファイル取得用カメラ464の撮像面464aに入射す る。

【 0 0 8 7 】

ー対のレンズ422,423は、液晶層216の反射面410aにおけるレーザ光Lの 波面を、集光レンズユニット430の入射瞳面430aと、ダイクロイックミラー403 の下流側(後段)の共役面491と、にリレーする。レンズ463は、一対のレンズ42 2,423によって共役面491にリレーされたレーザ光Lの波面(液晶層216におけ る実像)を、プロファイル取得用カメラ464の撮像面464aにリレー(結像)する。 これにより、液晶層216と、集光レンズユニット430の入射瞳面430aと、共役面 491と、プロファイル取得用カメラ464の撮像面464aとは、互いに共役の関係を 構成する。すなわち、レーザ加工装置200は、集光レンズユニット430の入射瞳面4 30aと共役な撮像面464aを有し、レーザ光Lの画像を取得するプロファイル取得用 カメラ464を備えている。

10

20

[0088]

プロファイル取得用カメラ464は、ダイクロイックミラー403で分岐されたレーザ 光Lの強度分布を取得する撮像装置である。具体的には、プロファイル取得用カメラ46 4は、反射型空間光変調器410から出射され集光レンズユニット430に入射する前の レーザ光Lについてのビーム断面の強度分布に関する画像(強度分布画像)を静止画像と して撮像する。撮像した強度分布画像を制御部500へ出力する。プロファイル取得用カ メラ464としては、例えば、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) イメージセンサが用いられる。

(17)

【0089】

レーザ光Lの光路におけるレンズ422の後側の焦点位置には、スリット部材424が 10 配置されている。スリット部材424は、レーザ光Lにおける一定値以上の空間周波数成分を 通過させる。例えばスリット部材424では、一定値以上の空間周波数成分を遮光するように、開口の大きさが設定されている。例えば、反射型空間光変調器410(液晶層21 6)に回折格子パターンを含む位相パターンが表示されているときには、スリット部材4 24は、当該回折格子パターンに応じて回折されたレーザ光Lの一定次数以上の回折光(例えば正負の高次回折光)を遮断する。

【0090】

ちなみに、スリット部材424は、レンズ422の後側の焦点位置の近傍に配置されて いてもよい。焦点位置の近傍とは、略焦点位置、焦点位置の付近、もしくは焦点位置の周 辺であって、スリット部材424がレーザ光しにおける一定値以上の空間周波数成分を遮 光できる範囲(一定次数以上の回折光を遮断できる範囲)である(以下、同じ)。スリッ ト部材424を通過後のレーザ光しでは、反射型空間光変調器410によるレーザ光しの 変調を強度変調として容易に観測できる。

【0091】

制御部500は、上記レーザ光源制御部102と、空間光変調器制御部(制御部)50 2、カメラ制御部504、判定部506、及び、記憶部510を有している。レーザ光源 制御部102は、上述したように、レーザ発振器310の動作を制御する。また、レーザ 光源制御部102は、1つの切断予定ライン5に沿うレーザ加工毎において、加工条件(照射条件)に基づいて、レーザ発振器310で発生させるレーザ光Lの出力を決定して設 定する。加工条件は、例えばタッチパネル等の入力部によりオペレータから入力される。 加工条件としては、例えば、加工対象物1における改質領域7を形成する深さ位置、レー ザ出力等である。

【0092】

ここで、レーザ加工装置200は、レーザ光Lを加工対象物1に照射することにより加 工対象物1のレーザ加工を行う第1モードと、第1モードと異なる第2モードと、を少な くとも有する。第1モードは、上記の通り加工モードである。第2モードは、例えば、レ ーザ加工装置200の立ち上げ時といった加工モードの実行の前、或いは、加工対象物1 の交換時といった加工モード間において、レーザ光Lの強度を測定するための計測モード である(例えばキャリブレーションモード)。レーザ加工装置200の各モードの切り替 えは、オペレータの入力により手動で行われてもよいし、自動で行われてもよい。一例と して、レーザ加工装置200の立ち上げ時に、第1モードの実行に先立って、自動的(強 制的)に第2モードが実行されてもよい。

【0093】

レーザ光Lの強度の測定は、例えば、レーザ光Lの光路における集光レンズユニット4 30の後段に配置されたパワーメータ520を用いて行うことができる。パワーメータ5 20は、例えば、集光レンズユニット430から出射されたレーザ光Lの集光点に配置さ れる。或いは、レーザ光Lの強度の測定は、上述したように、プロファイル取得用カメラ 464により取得されたレーザ光Lの画像(強度分布画像)に基づいてレーザ光Lの強度 を取得することにより行われてもよい。さらには、レーザ光Lの強度の測定は、上記の光 30

軸位置モニタ用のカメラ473の撮像結果に基づいてレーザ光Lの強度を取得することに より行われてもよい。レーザ光Lの強度に関する情報は、判定部506に送信される。 【0094】

空間光変調器制御部502は、反射型空間光変調器410の液晶層216に表示する位 相パターンを制御する。特に、空間光変調器制御部502は、第2モードが実行されてい るときに、反射型空間光変調器410に表示する位相パターンを切り替えるための切替制 御を行う。切替制御は、反射型空間光変調器410に表示する位相パターンを、ある位相 パターンから別の位相パターンに切り替えるための信号を反射型空間光変調器410に送 信する制御である。また、ある位相パターンから別の位相パターンに切り替えるとは、あ る位相パターンの表示を停止した後に別の位相パターンを表示する場合もあるし、ある位 相パターンが表示されている状態において、ある位相パターンにさらにパターンを重畳し て別の位相パターンを構成する場合もある。

【0095】

反射型空間光変調器410に表示する位相パターンは、一例として、収差補正パターン を含む位相パターン、回折格子パターンを含む位相パターン、収差補正パターン及び回折 格子パターンを含む位相パターン(すなわち、収差補正パターンに回折格子パターンを重 畳させて構成された位相パターン)等である。なお、ここでは、液晶層216に屈折率分 布が生じていない場合(例えば画素電極214に電圧を印可していない場合)、すなわち 、レーザ光Lに対して実質的に位相変調を付加しないパターンについても、1つの位相パ ターンとする。

【0096】

図17の(a)は、回折格子パターンである位相パターンの一例である。反射型空間光 変調器410にこの位相パターンP2が表示されている場合、反射型空間光変調器410 から出射されたレーザ光Lは、この位相パターンP2に応じて回折される。これにより、 図17の(b)に示されるように、レンズ422の後側の集光位置において、レーザ光L の各回折光に応じた複数のビームスポットLSが形成される。したがって、スリット部材 424のスリット424aの形状を調整することにより、回折光のうちの一部(一定次数 以上の回折光)を遮断することができる。

【0097】

カメラ制御部504は、プロファイル取得用カメラ464、及び、光軸位置モニタ用の 30 カメラ473の動作を制御する。また、カメラ制御部504は、強度分布画像をプロファ イル取得用カメラ464やカメラ473から取得して認識する。これにより、カメラ制御 部504は、レーザ光Lの強度を取得することができる。取得されたレーザ光Lの強度に 関する情報は、上記のように判定部506に送信される。

【0098】

判定部506は、第2モードが実行されているときに、反射型空間光変調器410の動作が正常であるか否かの判定を行う。反射型空間光変調器410の動作が正常であるとは、例えば、空間光変調器制御部502の制御の下で、駆動回路層914が画素電極214 に所定の電圧を印可したときに、意図した位相パターンが液晶層216に表示される状態である。これは、液晶層216を介して反射型空間光変調器410から出射されたレーザ光Lの強度に基づいて判定することができる。

【0099】

すなわち、空間光変調器制御部502による位相パターンの切替制御の前と切替制御の 後との間において、反射型空間光変調器410に表示される位相パターンが変化すれば、 反射型空間光変調器410から出射されたレーザ光Lの強度に変化が生じ得る。一方、空 間光変調器制御部502による位相パターンの切替制御の前と切替制御の後との間におい て、反射型空間光変調器410に表示される位相パターンが変化しなければ、反射型空間 光変調器410から出射されたレーザ光Lの強度に変化が生じない。したがって、切替制 御の前と後とにおいて、レーザ光Lの強度に変化が生じているか否かに基づいて、反射型 空間光変調器410の動作が正常であるか否かの判定を行うことが可能である。 10

[0100]

つまり、判定部506は、空間光変調器制御部502による位相パターンの切替制御の 前と切替制御の後との間におけるレーザ光Lの強度の変化に基づいて、反射型空間光変調 器410の動作が正常であるか否かの判定を行う。この点については、反射型空間光変調 器410の動作確認方法としても後述する。

(19)

【0101】

記憶部510は、判定部506の判定結果を保存する。なお、記憶部510は、例えば 、反射型空間光変調器410に表示するための複数の位相パターンを予め記憶してもよい

[0102]

10

制御部500には、モニタ600が接続されている。モニタ600は、記憶部510に 記憶された判定部506の判定結果を表示することができる。また、モニタ600は、空 間光変調器制御部502により反射型空間光変調器410(液晶層216)に表示させる 位相パターン、及び、プロファイル取得用カメラ464及びカメラ473で取得した強度 分布画像を表示することができる。なお、判定部506の判定結果は、記憶部510を介 さずにモニタ600に表示されてもよい。

【0103】

引き続いて、レーザ加工装置200の反射型空間光変調器410の動作確認方法について、図18のフローチャートを参照しつつ説明する。

[0104]

本実施形態に係る動作確認方法においては、まず、制御部500が、レーザ加工装置200のモードを動作確認モードに設定する(ステップS1)。動作確認モードは、加工モードとしての第1モードとは異なる第2モードであって、ここではレーザ光Lの強度の計測モードである。一例として、ここでは、制御部500が、レーザ加工装置200の立ち上げ時に強制的に(自動的に)、レーザ加工装置200を計測モードに設定する。

続いて、レーザ光Lの光路における集光レンズユニット430の後段(例えば、Z軸方向における集光レンズユニット430の下方)にパワーメータ520を配置する(ステップS2)。パワーメータ520は、例えば、集光レンズユニット430から出射したレー ザ光の集光点に配置される。

【0106】

続いて、空間光変調器制御部502の制御により、反射型空間光変調器410が位相パ ターンを表示する(ステップS3)。より具体的には、ここでは、空間光変調器制御部5 02が、駆動回路層914に信号を送ることにより画素電極214に電圧を印可させ、液 晶層216に位相パターンを表示させる。このステップS3において反射型空間光変調器 410に表示する位相パターンは、回折格子パターンを含まない第1パターンである。第 1パターンは、例えば収差補正パターン等を含んでいてもよい。

[0107]

続いて、レーザ光源制御部102の制御により、レーザ出力部300(レーザ発振器3 10)がレーザ光Lを出力する。レーザ光Lは、反射型空間光変調器410及び集光レン ズユニット430を介してパワーメータ520に入射する。これにより、パワーメータ5 20は、レーザ光Lの強度を計測する(ステップS4)。強度の計測結果は、判定部50 6に送信される。

【0108】

続いて、空間光変調器制御部502が、反射型空間光変調器410に表示する位相パタ ーンを切り替えるための切替制御を行う(第1ステップ、ステップS5)。より具体的に は、ここでは、空間光変調器制御部502が、先に表示していた第1パターンと異なる位 相パターンに切り替えて表示するための信号を反射型空間光変調器410に送信する。こ のステップS5において反射型空間光変調器410に表示させる位相パターンは、第1パ ターンと異なるパターンであって、回折格子パターンを含む第2パターンP2(図17の 20



(a) 参照) である。第2 パターン P2 は、例えば、収差補正パターンをさらに含んでいてもよい。

【0109】

続いて、パワーメータ520が、再び、レーザ光Lの強度を計測する(ステップS6) 。反射型空間光変調器410が正常に動作している場合には、反射型空間光変調器410 に表示されている位相パターンが、第1パターンから回折格子パターンを含む第2パター ンP2に切り替わっている。このため、反射型空間光変調器410から出射されたレーザ 光Lは、回折格子パターンに応じて回折される。そして、回折光のうちの一定次数以上の 回折光は、スリット部材424により遮断され、パワーメータ520に入射しない。その 結果、ステップS4における強度の計測結果と、このステップS6における強度の計測結 果とは、互いに異なる。ステップS6において計測される強度は、ステップS4において 計測される強度よりも小さい。強度の計測結果は、判定部506に送信される。 【0110】

続いて、判定部506が、切替制御の前と切替制御の後との間のレーザ光Lの強度の変 化に基づいて、反射型空間光変調器410の動作が正常であるか否かの判定を行う(第2 ステップ)。より具体的には、判定部506は、ステップS4において計測された強度か ら、ステップS6において計測された強度を減算することにより、強度差を計算する(第 2ステップ、ステップS7)。すなわち、ここでは、判定部506が、切替制御の前のレ ーザ光Lの強度から、切替制御の後のレーザ光Lの強度を減算して強度差を計算する。そ して、判定部506が、ステップS7において計算された強度差が、予め設定された閾値 よいも大きいか否かの判定を行う(第2ステップ、ステップS8)。

上述したように、反射型空間光変調器410の動作が正常であれば、切替制御の後に反 射型空間光変調器410に入射したレーザ光Lは、第2パターンP2に含まれる回折格子 パターンにより回折され、切替制御の前のレーザ光Lの強度に比べて一定以上小さくなる 。したがって、切替制御の前後の強度差が閾値よりも大きければ(ステップS8:YES)、反射型空間光変調器410の動作が正常であることが特定される。したがって、続く ステップでは、制御部500が、動作確認モードを終了し、レーザ加工装置200のモー ドを加工モードに設定する(ステップS9)。

【0112】

一方、切替制御の前後の強度差が閾値以下であれば(ステップS8:NO)、反射型空間光変調器410の動作が正常でないことが特定される(エラーが検出される)。したがって、続くステップでは、反射型空間光変調器410のエラー時の処理が行われる(ステップS10)。エラー時の処理は、一例として、ステップS3以降を再度実行する処理や、レーザ加工装置200の動作を停止する処理である。

【0113】

以上説明したように、本実施形態に係るレーザ加工装置200及びその動作確認方法に おいては、レーザ加工を行う第1モードと異なる第2モードが実行されているときに、反 射型空間光変調器410に表示する位相パターンの切替制御が行われる。反射型空間光変 調器410の動作が正常であれば、切替制御の前後において異なる位相パターンによりレ ーザ光Lが変調され、強度変化が生じる。一方、反射型空間光変調器410の動作が正常 でない場合には、切替制御の前後において位相パターンが適切に切り替わらない結果、レ ーザ光Lの強度変化が生じない場合がある。したがって、第2モードが実行されていると きに、切替制御の前後のレーザ光Lの強度の変化に基づいて、反射型空間光変調器410 の動作が正常であるか否かの判定を行うことにより、加工時以外のタイミングで反射型空 間光変調器410の動作確認を行うことが可能である。

【0114】

また、レーザ加工装置200及びその動作確認方法においては、空間光変調器制御部5 02が、第2モードが実行されているときに、反射型空間光変調器410に表示する位相 パターンを第1パターンから回折格子パターンを含む第2パターンに切り替えるための切

30

20

10

替制御を行う。そして、判定部506が、切替制御の前のレーザ光Lの強度から切替制御の後のレーザ光Lの強度を減算して強度差を計算すると共に、その強度差が閾値よりも大きいか否かに基づいて、反射型空間光変調器410の動作が正常であるか否かの判定を行う。

【0115】

この場合、反射型空間光変調器410の動作が正常であれば、切替制御の後に反射型空間光変調器410に入射したレーザ光しは、第2パターンに含まれる回折格子パターンに より回折される。したがって、一部の回折光の強度に着目すれば、切替制御の前のレーザ 光しの強度に比べて一定以上小さくなる。したがって、切替制御の前後の強度差を所定の 閾値と比較することにより、反射型空間光変調器410の動作が正常であるか否かが容易 且つ確実に判定可能である。

【0116】

また、レーザ加工装置200は、レーザ光Lの光路における反射型空間光変調器410 と集光レンズユニット430との間に配置され、レーザ光Lを集束するレンズ422と、 レーザ光Lの光路におけるレンズ422の後側の焦点位置に配置され、回折格子パターン に応じて回折されたレーザ光Lの一定次数以上の回折光を遮断するスリット部材424と 、を備えている。このため、反射型空間光変調器410の動作が正常であるときに、焦点 位置において一定次数以上の回折光を遮断することによって、切替制御の前後における強 度差を十分に生じさせることができる。したがって、反射型空間光変調器410の動作が 正常であるか否かの判定がより容易且つ確実となる。

[0117]

さらに、レーザ加工装置200及びその動作確認方法においては、第2モードは、集光 レンズユニット430から出射されたレーザ光Lの強度を測定するための計測モードであ る。また、判定部506は、レーザ光Lの光路における集光レンズユニット430の後段 に配置されたパワーメータ520により取得されたレーザ光Lの強度に基づいて判定を行 う。このため、通常の動作として行われるキャリプレーションモードとしての計測モード を利用して、反射型空間光変調器410の動作確認が可能となる。

【0118】

次に、第2実施形態について説明する。図19は、第2実施形態に係るレーザ加工装置 200Bの要部を示す概略構成図である。図19に示されるように、本実施形態のレーザ 加工装置200Bが上記レーザ加工装置200(図16参照)と異なる点は、レーザ光L の光路において、反射型空間光変調器410とプロファイル取得用カメラ464との間に 配置された集束レンズであるレンズ463の焦点位置に、スリット部材424Bが配置さ れている点である。スリット部材424Bは、上記スリット部材424と同様に構成され ている。なお、スリット部材424Bは、レンズ463の焦点位置の近傍に配置されてい てもよい。

[0119]

この場合、反射型空間光変調器410から出射されたレーザ光Lの回折光が、スリット 部材424Bを介してプロファイル取得用カメラ464に入射する一方で、スリット部材 を介さずに集光レンズユニット430に入射する。したがって、プロファイル取得用カメ ラ464においては、レーザ光Lのうちの一定次数以上の回折光が遮断された残部の画像 が取得される。つまり、切替制御の前後のレーザ光Lの強度差は、集光レンズユニット4 30の後段よりも、プロファイル取得用カメラ464において大きくなり得る。このため 、ここでは、判定部506は、プロファイル取得用カメラ464により取得された画像に 基づいて、レーザ光Lの強度を取得し、取得した強度に基づいて、上記のような判定を行 う。この場合には、パワーメータ520を用いることなく、レーザ加工装置200が予め 備えている構成を利用して、反射型空間光変調器410の動作確認が可能である。 【0120】

以上、レーザ加工装置200Bにおいても、レーザ加工装置200と同様に、加工時以 外のタイミングで反射型空間光変調器410の動作確認を行うことが可能であるという上 ⁵⁰

10

30

記効果が奏される。

【0121】

図20は、第2実施形態の変形例に係るレーザ加工装置200Cの要部を示す概略構成 図である。図20に示されるように、第2実施形態に係る変形例として、レーザ光Lの光 路においてレンズ463とプロファイル取得用カメラ464との間にレンズ463Cを備 えたレーザ加工装置200Cを採用することができる。レンズ463Cは、レンズ463 で集束されたレーザ光Lをコリメートしてプロファイル取得用カメラ464へ入射させる 。レンズ463Cは、リレーレンズを構成する。レンズ463,463Cは、共役面49 1にリレーされたレーザ光Lの波面(液晶層216における実像)をプロファイル取得用 カメラ464の撮像面464aにリレー(結像)する。

【0122】

以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限られ るものではなく、各請求項に記載した要旨を変更しない範囲で変形し、又は他のものに適 用してもよい。

【0123】

例えば、上記実施形態は、加工対象物1の内部に改質領域7を形成するものに限定され ず、アブレーション等、他のレーザ加工を実施するものであってもよい。上記実施形態は 、加工対象物1の内部にレーザ光Lを集光させるレーザ加工に用いられるレーザ加工装置 に限定されず、加工対象物1の表面1a,3又は裏面1bにレーザ光Lを集光させるレー ザ加工に用いられるレーザ加工装置であってもよい。

[0124]

上記実施形態において、反射型空間光変調器410の反射面410aと集光レンズユニット430の入射瞳面430aとが結像関係にある両側テレセントリック光学系を構成する結像光学系は、一対のレンズ422,423に限定されず、反射型空間光変調器410 側の第1レンズ系(例えば、接合レンズ、3つ以上のレンズ等)及び集光レンズユニット 430側の第2レンズ系(例えば、接合レンズ、3つ以上のレンズ等)を含むもの等であってもよい。

【0125】

上記実施形態において、プロファイル取得用カメラ464は、その撮像面464aが反 射型空間光変調器410の液晶層216の反射面と共役な面に位置すればよく、共役面4 91の位置にプロファイル取得用カメラ464を配置してもよい。この場合、レーザ加工 装置200(図16参照)においては、レンズ463は不要となる。上記実施形態におい て、レンズ422、レンズ423及びレンズ463のリレー倍率は任意倍率でもよい。上 記実施形態は、反射型空間光変調器410を備えたが、空間光変調器は反射型のものに限 定されず、透過型の空間光変調器を備えていてもよい。

【0126】

また、集光レンズユニット430及び一対の測距センサ450は、Y軸方向における筐体401の端部401dに取り付けられていたが、Y軸方向における筐体401の中心位置よりも端部401d側に片寄って取り付けられていればよい。反射型空間光変調器410は、Y軸方向における筐体401の端部401cに取り付けられていたが、Y軸方向における筐体401の中心位置よりも端部401c側に片寄って取り付けられていればよい。また、測距センサ450は、X軸方向において集光レンズユニット430の片側のみに配置されていてもよい。

【0127】

また、空間光変調器制御部502による切替制御の前後で反射型空間光変調器410に 表示する第1パターン及び第2パターンは、上記の組合せに限定されない。切替制御の前 後で反射型空間光変調器410に表示する位相パターンは、反射型空間光変調器410の 動作が正常であったときにレーザ光の強度差が生じ得る任意の位相パターンとすることが できる。例えば、第2パターンは、回折格子パターンを含まなくてもよい。 【0128】

20

10

なお、第2パターンが回折格子パターンを含む場合であっても、スリット部材を用いな くてもよい。これは、例えば、スリット部材を用いなくても、他の光学素子の開口によっ て、一定次数以上の回折光が遮断され得るためである。また、一定次数以上の回折光の遮 断の有無に関わらず、切替制御の前のレーザ光Lの強度と、切替制御の後のレーザ光Lの 一部の回折光(例えば0次回折光)の強度とを比較すれば、強度差が生じ得るためである

[0129]

さらに、レーザ加工装置200,200B,200Cは、加工モード及び計測モード以外の他のモードを有していてもよい。そして、反射型空間光変調器410の動作確認は、 その他のモードが実行されているときに行うことができる。

【0130】

ここで、図18に示されるステップS4及びステップS6の強度計測は、プロファイル 取得用カメラ464又は光軸モニタ用のカメラ473と、アパーチャーとの組み合わせを 用いて行うことができる。プロファイル取得用カメラ464とアパーチャーとを用いる場 合には、ステップS5において、図21の(a)に示される第2パターンP3を反射型空 間光変調器410に表示させる。この第2パターンP3は、パワーメータ520及びスリ ット部材424を用いる場合の第2パターンP2(図17の(a)参照)に含まれる回折 格子パターンと比べて、溝ピッチが相対的に狭い回折格子パターンを含む。このため、図 21の(b)に示されるように、回折光Ldの位置は、0次光の位置から十分に離れた位 置になる。したがって、アパーチャー径Daのアパーチャーにより回折光Ldがカットさ れ、ステップS4で計測される強度と、ステップS6で計測される強度との間に十分な強 度差が生じ得る。

【0131】

一方、光軸モニタ用のカメラ473とアパーチャーとを用いる場合には、図22の(a)に示されるように、第2パターンP2を反射型空間光変調器410に表示させる。この 第2パターンP2に含まれる回折格子パターンの溝ピッチは、上記の第2パターンP3の 場合に比べて広い。したがって、図22の(b)に示されるように、回折光Ldの位置が 0次光L0の位置に比較的近い。このため、回折光Ldのうちの少なくとも一部は、アパ ーチャー径Daのアパーチャーを通過する。したがって、この場合には、カメラ473の 画像のある領域に着目して、強度差を取得すればよい。具体的には、例えば図22の(b))の領域ARに着目すると、反射型空間光変調器410に第2パターンP2を表示してい るときには、回折光Ldが撮像されるので、相対的に強度が大きい。一方で、反射型空間 光変調器410に対して回折格子パターンを含まない第1パターンが表示されているとき には、光が撮像されない。よって、ステップS4で計測される強度と、ステップS6で計 測される強度との間に十分な強度差を取得できる。

【0132】

なお、アパーチャーを用いる場合には、アパーチャー部材を別途導入してもよいし、既 に設けられている光学部材の開口(4 f レンズユニット4 2 0 のレンズの瞳開口等)を利 用してもよい。

【符号の説明】

【0133】

1…加工対象物(対象物)、P2…位相パターン(第2パターン)、100,200, 200B,200C…レーザ加工装置、310…レーザ発振器(レーザ光源)、410… 反射型空間光変調器(空間光変調器)、422…レンズ(集束レンズ)、424,424 B…スリット部材、430…集光レンズユニット(対物レンズ)、430a…入射瞳面(瞳面)、463…レンズ(集束レンズ)、464…プロファイル取得用カメラ(カメラ) 、464a…撮像面、502…空間光変調器制御部(制御部)、506…判定部、L…レ ーザ光。 20

10

30





【図3】

【図4】







【図7】

【図8】





303 🔘

320-

Z

~~ 0

¥ Y

3Ò4

302

≻X

310

D

330 340

300

Ø

363

350

Ĺ

-301a

301

362

-361

-361a

-360

【図10】



【図11】

【図12】

Z ♠





【図13】

【図14】





【図15】

【図16】





【図17】

【図18】

(28)



【図19】

【図20】

END





, P2

【図22】







Ld

フロントページの続き

(56)参考文献 特開2014-138956(JP,A) 特開2011-51011(JP,A) 国際公開第2013/153371(WO,A1) 国際公開第2015/159687(WO,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

B 2 3 K 2 6 / 0 0 B 2 3 K 2 6 / 0 6 2